
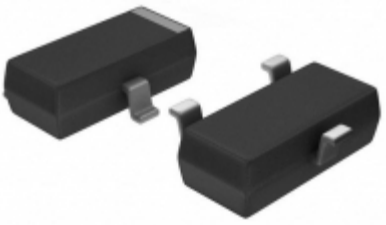
	<p><b>SI2323DS-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI2323DS-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI2323DS-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 173118 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2323DS-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	173118 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 4.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1020pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI2323DS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2323DS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2323DS-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2323DS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2323DS-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2324DS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 2.3A SOT-23</p>	 <p><b>SI2324DS-T1-E3</b> VISHAY SI2324DS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI2323DS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p>
 <p><b>SI2323DS-T1</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23</p>	 <p><b>SI2324DS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 2.3A SOT-23</p>	 <p><b>SI2323DS-T1-E3</b> VIS VIS SOT-23</p>	 <p><b>SI2323DS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI2319CDS-T1-GE3	↔ SI2319DDS-T1-GE3	➔ SI2319DS	D SI2319DS-T1-E3	➔ SI2319DS-T1-E3
⊖ SI2319DS-T1-GE3	⊕ SI2319DS-T1-GE3	D SI2320DS	➔ SI2320DS-T1-E3	➔ SI2320DS-T1-GE3
⊕ SI2321DS-T1-E3	⊖ SI2321DS-T1-E3	⊕ SI2321DS-T1-GE3	↔ SI2321DS-T1-GE3	➔ SI2323CDS-T1
D SI2323CDS-T1-E3	⊕ SI2323CDS-T1-GE3	⊖ SI2323CDS-T1-GE3	⊕ SI2323DDS-T1-E3	➔ SI2323DDS-T1-GE3
➔ SI2323DDS-T1-GE3	↔ SI2323DS	⊕ SI2323DS-T1-E3	⊖ SI2323DS-T1-E3	➔ SI2323DS-T1-GE3
↔ SI2324DS-T1-E3	➔ SI2324DS-T1-GE3	D SI2324DS-T1-GE3	⊕ SI2325DS-T1-E3	⊖ SI2325DS-T1-E3
⊕ SI2325DS-T1-GE3	D SI2325DS-T1-GE3	➔ SI2327DS-T1-E3	↔ SI2327DS-T1-E3	➔ SI2327DS-T1-GE3
⊖ SI2327DS-T1-GE3	⊕ SI2328DS	↔ SI2328DS-T1	➔ SI2328DS-T1-E3	➔ SI2328DS-T1-E3
⊕ SI2328DS-T1-GE3	⊖ SI2328DS-T1-GE3	⊕ SI2329DS-T1-E3	D SI2329DS-T1-GE3	➔ SI2329DS-T1-GE3
↔ SI2331DS	⊕ SI2331DS-T1-E3	⊖ SI2331DS-T1-E3	⊕ SI2331DS-T1-GE3	➔ SI2331DS-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited